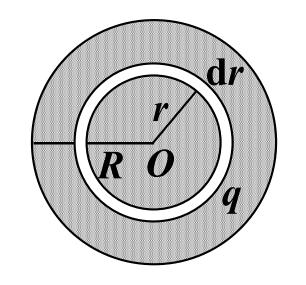
【例1】半径 R、均匀带电 q 的球体的静电能

解: 考察 r-r+dr 的球壳,

其电量和所在处的电势为:

$$dq = (\frac{q}{4\pi R^3/3})4\pi r^2 dr = \frac{3qr^2}{R^3} dr$$



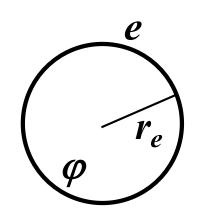
$$\varphi(r) = \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 R^3} (3R^2 - r^2)$$

均匀带电球的静电能为:

$$W = \frac{1}{2} \int_{q}^{q} \varphi dq = \frac{1}{2} \int_{0}^{R} \frac{q}{8\pi \varepsilon_{0} R^{3}} (3R^{2} - r^{2}) \frac{3qr^{2}}{R^{3}} dr$$

$$W = \frac{3}{20\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q^2}{R} = \frac{4\pi}{15\varepsilon_0} \rho^2 R^5$$

【例2】设电子 $W \approx m_0 c^2$,估算其经典半径。



(1) 假定电荷 e 均匀分布于电子表面

$$W = \frac{1}{2} \int_{e} \varphi dq = \frac{1}{2} \varphi e = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{2}}{4\pi \varepsilon_{0} r_{e}} \approx m_{0} c^{2}$$

$$r_{e} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{2}}{4\pi \varepsilon_{0} m_{0} c^{2}} \approx 1.4 \times 10^{-15} \text{ m}$$

(2) 假定电子是均匀带电球,可得:

$$W = \frac{3}{5} \cdot \frac{e^2}{4\pi \varepsilon_0 r_e}, \quad r_e \approx \frac{3}{5} \cdot \frac{e^2}{4\pi \varepsilon_0 m_0 c^2} \approx 1.7 \times 10^{-15} \text{ m}$$

两种假定情况得到的 r_e 的数量级相同。

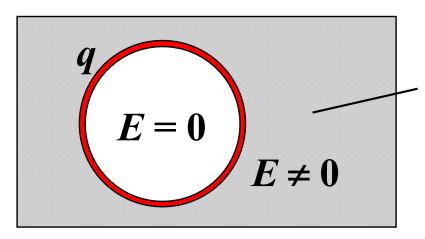
电子经典半径常取为
$$r_e = \frac{e^2}{4\pi \varepsilon_0 m_0 c^2} \approx 2.8 \times 10^{-15} \text{ m}$$

目前的实验测量表明电子线度 < 3.9×10⁻¹⁹ m, 远小于电子经典半径 ~10⁻¹⁵ m, 说明电子并非经典粒子。

§ 13.7 静电场的能量

根据 $W = \frac{1}{2} \int_{q} \varphi \, \mathrm{d}q$,似乎可认为能量集中在电荷分布区域,这种观点是错误的。

实际上,静电能存储在静电场分布的区域。



均匀带电球面的静电能分布于球面以外空间中。

对变化的电磁场,电磁场储能不仅被证明是正确的、必要的,而且是唯一的客观实在。

真空中静电场的能量密度

$$\boldsymbol{w}_e = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}V} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon}_0 E^2$$

在静电场分布的空间 1/中,存储的静电能:

$$W = \iiint_{V} \boldsymbol{w}_{e} \, dV = \iiint_{V} \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon}_{0} E^{2} \, dV$$

静电学中
二者等价
$$W = \frac{1}{2} \int_{q} \varphi \, \mathrm{d} q$$

$$W = \iiint_{V} \frac{1}{2} \varepsilon_{0} E^{2} \, \mathrm{d} V$$

【例】求均匀带电球面的静电场能量

解: 电场在球面内为零,能量分布在面外:

$$\boldsymbol{w}_{e} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon}_{0} E^{2} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon}_{0} \left(\frac{q}{4 \pi \boldsymbol{\varepsilon}_{0} r^{2}}\right)^{2}$$
$$= \frac{q^{2}}{32 \pi^{2} \boldsymbol{\varepsilon}_{0} r^{4}} \qquad (r > R)$$

$$W = \int_{R}^{\infty} \frac{q^2}{32 \pi^2 \varepsilon_0 r^4} \cdot 4 \pi r^2 dr = \frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{4 \pi \varepsilon_0 R}$$

$$W = \frac{1}{2} \int_{q} \varphi \, \mathrm{d} \, q = \frac{1}{2} \cdot \frac{q}{4 \pi \varepsilon_{0} R} \cdot q = \frac{1}{2} \cdot \frac{q^{2}}{4 \pi \varepsilon_{0} R}$$

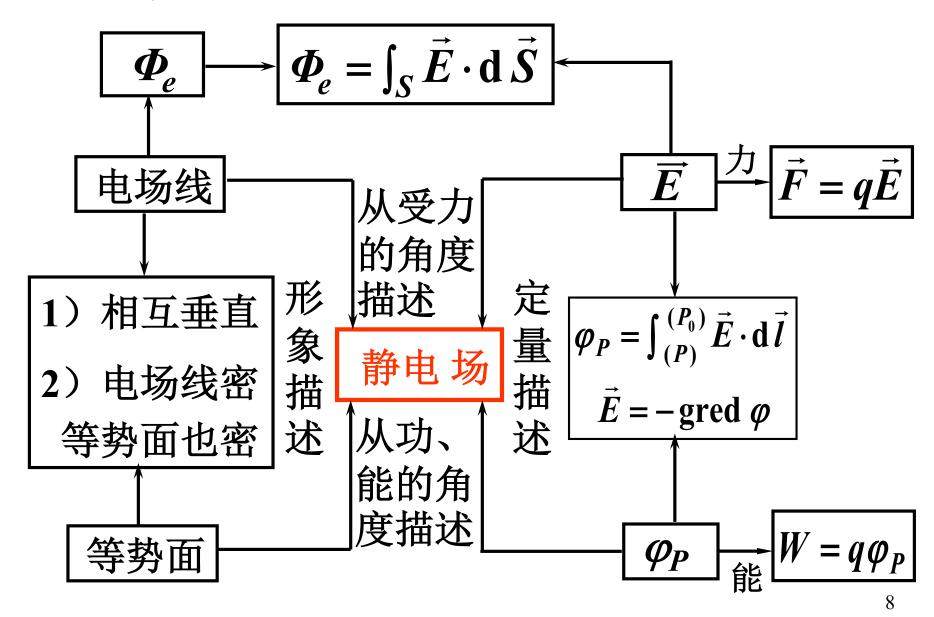
真空中静电场小结提纲

一.线索(基本定律、定理):

库仑定律
$$\vec{E} = \vec{F} / q_0$$
 $\vec{E} = \sum_i \frac{q_i \vec{e}_{r_i}}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}$ $\rightarrow \vec{E} = \sum_i \frac{q_i \vec{e}_{r_i}}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}$ $\rightarrow \begin{bmatrix} \vec{f} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q_{|\gamma|}}{\varepsilon_0} \\ \vec{f} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \end{bmatrix}$

还有电荷守恒定律,它时刻都起作用。

二. 基本物理量之间的关系:



三. 求场的方法:

叠加法(补偿法): $\vec{E} = \sum_{i} \vec{E}_{i}$,

$$\vec{E} = \int_{q} \frac{\vec{e}_{r}}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} dq ;$$

1. 求 \vec{E} $\begin{cases} i & 4\pi \varepsilon_0 r \\ \text{高斯定理法}: & \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q_{\text{H}}}{\varepsilon_0}; \\ \text{微分法}: & \vec{E} = -\nabla \varphi, \quad E_l = -\frac{\partial \varphi}{\partial l}. \end{cases}$

四.几种典型电荷分布的场强和电势:(自己总结)点电荷;均匀带电薄球壳;均匀带电大平板;均匀带电长直线;均匀带电长圆筒。

第十三章作业

13.2, 13.3, 13.6, 13.9, 13.15, 13.20,

13.22, 13.29

【思考】思考题13.3

中英文名称对照表

电势 — electric potential

环路定理 — circuital theorem

环流 — circulation

电势差 — electric potential difference

电势梯度 — electric potential gradient



第十三章结束



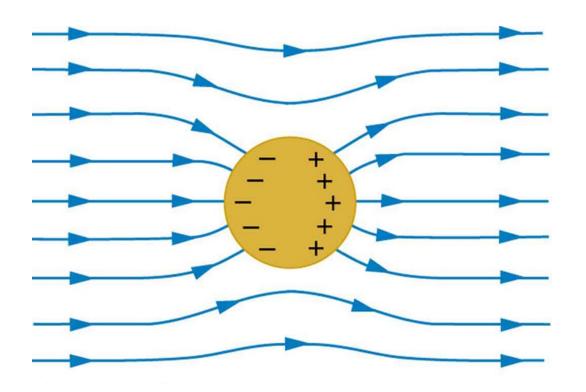
第十四章 静电场中的导体

§ 14.1 导体的静电平衡条件

- § 14.2 静电平衡时导体上的电荷分布 ▶
- § 14.3 有导体时静电场的分析与计算 ■
- § 14.4 静电唯一性定理

§ 14.5 导体壳和静电屏蔽

§ 14.6 电像法



§ 14.1 导体的静电平衡条件

这里只讨论各向同性、均匀的金属导体。

金属导体:存在大量可自由移动的电子,

电子对电场变化响应很快(~10-9s)。

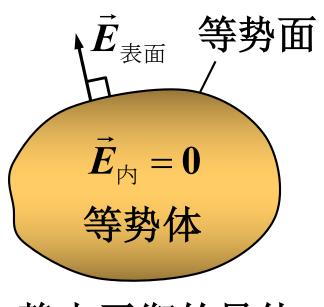
静电平衡过程:

导体放入电场 → 自由电子定向运动 → 改变导体电荷分布 → 改变电场 → ··· → 导体内部和表面无自由电荷的定向移动

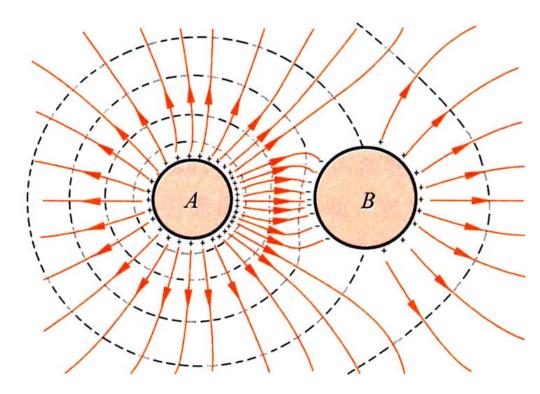
— 电场和导体之间达到静电平衡

导体静电平衡的条件

导体内部 $\vec{E}_{\text{內}} = 0$, $\vec{E}_{\text{表面}} \perp$ 表面。 导体是等势体,导体表面是等势面。



静电平衡的导体



【TV】导体的静电平衡

§ 14.2 静电平衡时导体上的电荷分布

一. 静电平衡时,导体内部各处净电荷为零, 所带电荷只能分布在导体表面上

证明:在导体内任取高斯面S,包围体积V,

$$\vec{E}_{|\gamma|} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \oiint_{S} \vec{E}_{|\gamma|} \cdot \mathbf{d} \, \vec{s} = \frac{\sum q_{|\gamma|}}{\varepsilon_{0}} = \mathbf{0}$$

$$\therefore \iiint_V \rho_{\bowtie} \, \mathrm{d} V = 0$$

令 $S \rightarrow 0$,则必有 $\rho_{\text{H}} = 0$ 。

二. 导体表面处场强与面电荷密度的关系

选跨导体表面的小扁柱面 为高斯面 S:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = (\iint + \iint + \iint)\vec{E} \cdot d\vec{s}$$
小扁柱面 上表面 下表面 侧面

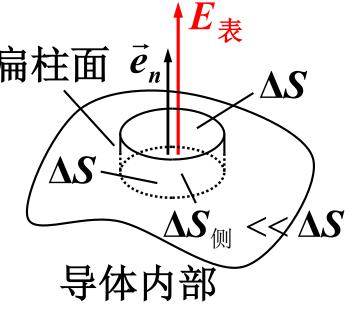
$$=\vec{E}_{\pm}\cdot(\Delta S\vec{e}_{n})$$

$$\stackrel{\text{(B)}}{=} \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0}$$

$$ec{E}_{rac{d}{arepsilon_0}} = rac{oldsymbol{\sigma}}{arepsilon_0} ec{e}_n$$

 $\vec{E}_{\pm} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{e}_n$ | \vec{e}_n : 由导体内指 向导体外

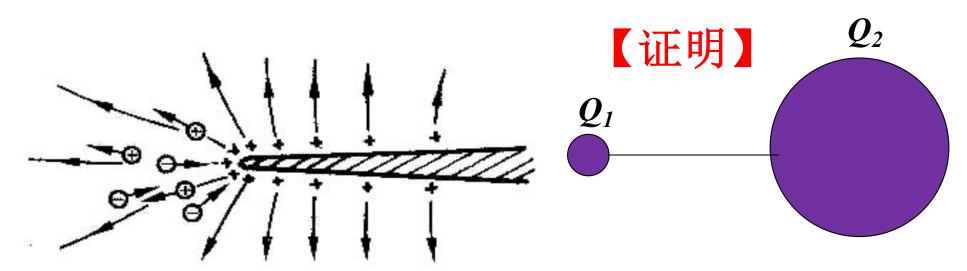
【思考】 \vec{E}_{*} 只是由小扁柱面内电荷产生的吗?



三. 孤立导体表面电荷分布的特点

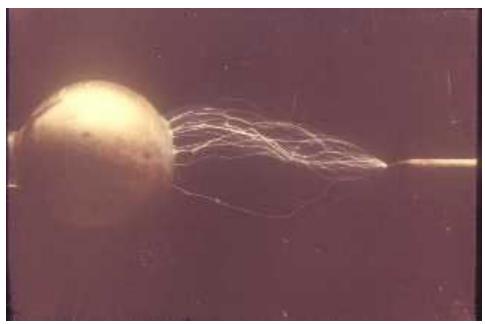
孤立导体表面曲率大处,面电荷密度也大,但不存在单一函数关系。

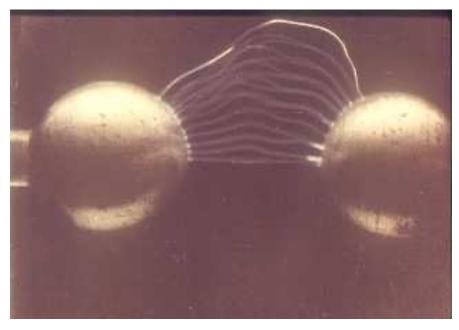
尖端放电: 带电的尖端电场强, 使附近的空气电离, 因而产生放电。



空气中的直流高压放电图片









俘获闪电:激光束引起空气电离,使闪电改道 22

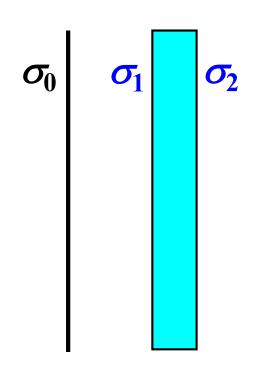
【演示】

- 带电导体空腔外表面带电,内表面不带电
- 孤立导体表面曲率大处,面电荷密度也大
- 尖端放电: 电风轮电风"吹"蜡烛
- 范式起电机

【TV】静电除烟尘

§ 14.3 有导体时静电场的分析与计算

基本依据: 静电平衡条件,电荷守恒, 高斯定理,环路定理 (电势、电场线的概念)



【例】面电荷密度 σ_0 的均匀带电大平板旁,平行放置一大的不带电导体平板。

求: 导体板两表面的面电荷密度 $\sigma_1 \setminus \sigma_2$ 。

解: 电荷守恒:

在导体板内部任证导体内场强为零:

$$\sigma_1 + \sigma_2 = 0 \tag{1}$$

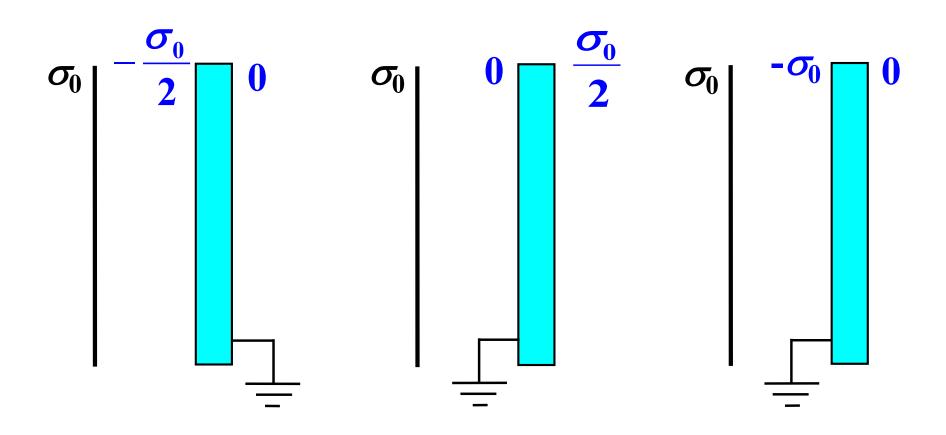
在导体板内部任选 P 点分析:

$$\vec{E}_0 + \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 0$$

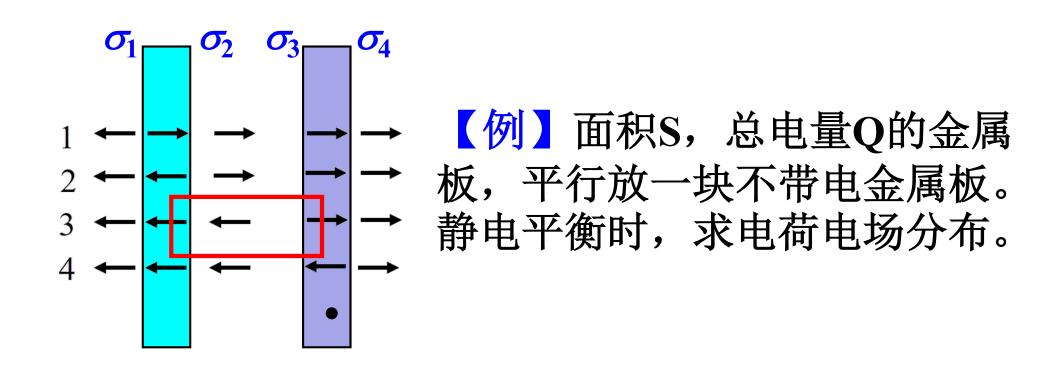
$$\Rightarrow \frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} = 0 \quad (2)$$

(1)(2) 解得:
$$\sigma_1 = -\sigma_2 = -\frac{\sigma_0}{2}$$

【讨论】若导体板接地,下面结果哪个正确?

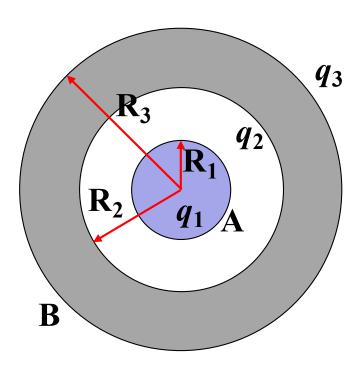


注意: 这应是一个新的静电平衡后的结果。



右板接地会怎么样?

教科书上: 例14.1



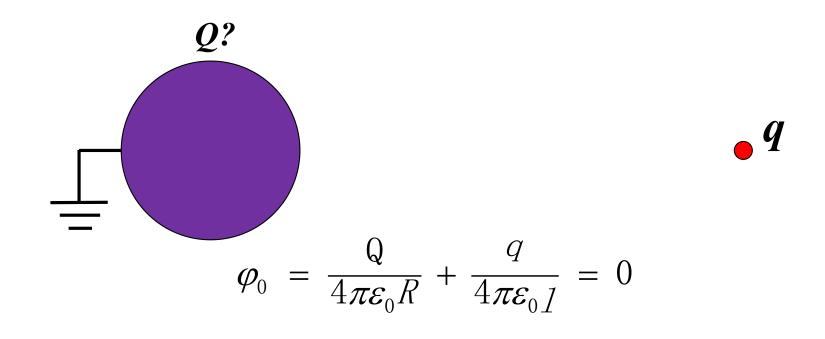
教科书上: 例14.2

【例】金属球A,半径 R_1 ,外面套一个同心金属球壳B,内外径分别为 R_2 , R_3 。两者带电后电势分别为 φ_A 、 φ_B 。求该系统电荷和电场分布。

$$- \left[\begin{array}{c} q_1 + q_2 = 0 \\ \varphi_{\text{A}} = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{q_3}{4\pi\varepsilon_0 R_3} \\ \varphi_{\text{B}} = \frac{q_1 + q_2 + q_3}{4\pi\varepsilon_0 R_3} \end{array} \right]$$

【要点:电势叠加原理!

【例】金属球半径为R接地,距球心l处,放置电荷q。求球上感应的电荷Q。

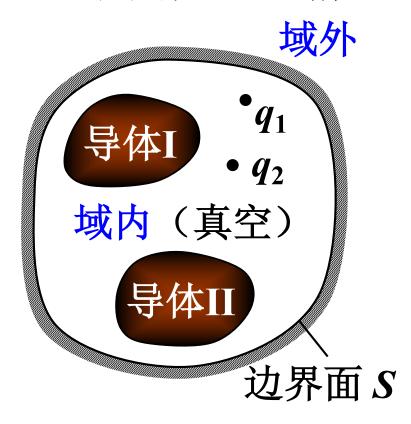


【问】金属球不接地时,金属球的电势?

【要点:金属球是等势体】

§ 14.4 静电唯一性定理

由下面典型的静电学问题介绍唯一性定理。



如图,域内和域外空间 由边界面S划分开。

设域内有若干点电荷和 导体。导体形状和位置、 边界面 S 都固定不变。

问题: 如何求解域内的电场分布 $\vec{E}(x,y,z)$, 需要知道什么条件 — 定解条件? 30

在以下条件任一给定时,空间的电场分布 $\tilde{E}(x,y,z)$ 以及表面的电荷分布是唯一确定的。条件如下:

- (a) 给定每个导体的总电量;
- (b) 给定每个导体的电势;
- (c) 给定一部分导体的电势,另一部分导体的电量。

静电平衡时: 电荷存在于表面(等势面),体内无净电荷,如上边值条件给定以后(真空与导体的边界),静电场的分布就唯一确定了。

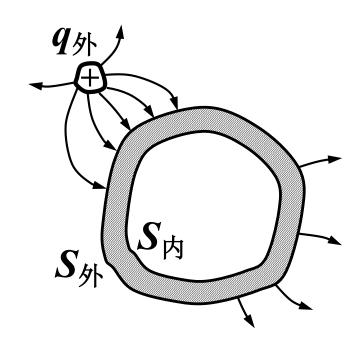
静电唯一性定理的意义

根据唯一性定理,可以猜解,只要不破坏原给定条件,所猜的解就是唯一正确的解。

§ 14.5 导体壳和静电屏蔽

封闭导体壳:有内表面 S_{Pl} 、外表面 S_{Pl} ,空间分割为腔内、腔外。

一. 腔内无电荷

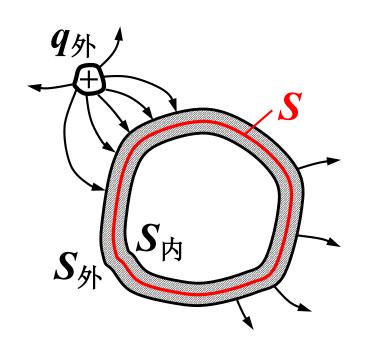


腔内无电荷时,无论腔外有无电荷,腔内电场为零,腔内表面处处无电荷。 它的内表面处处无电荷— 内表面的面电荷密度为零:

$$\vec{E}_{\text{h}}=0, \ \sigma_{\text{h}\, \pm\, \mathrm{m}}=0$$

封闭导体壳屏蔽了壳外电荷对壳内的影响。

证明:



在导体中选取高斯面S包围空腔,有:

$$\oiint_{S} \vec{E}_{\text{导体内}} \cdot \mathbf{d} \, \vec{s} = \mathbf{0}$$

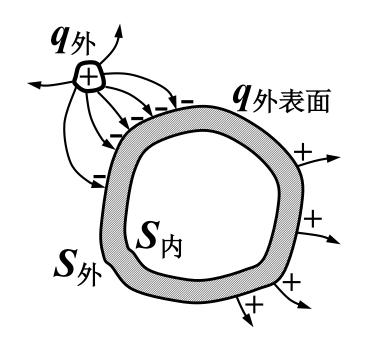
$$\Rightarrow \oint_{S_{h}} \sigma_{h, \pm m} ds = 0$$

若 $\sigma_{\text{内表面}} \neq 0$,则 $\sigma_{\text{内表面}}$ 必有正负,则腔内有电场线从正电荷到负电荷,与导体等势矛盾。

 \therefore 只能 $\sigma_{\text{内表面}} = 0$ 且腔内无电场线,即 $\vec{E}_{\text{内}} = 0$

注意证明过程并未涉及:

1) 导体壳本身是否带电, 2) 腔外是否有电荷表明: 腔内无电荷时,导体壳本身若带有净电荷,则所带净电荷和感应电荷只能分布在腔的外表面上。



【思考】

腔外电荷 q_h 大小、位置变化会影响腔内吗?

它是如何做到不影响的?

不管腔体外的电荷分布如何,腔体内没有感生电荷的产生,故场强处处为零。

利用此原理,在实验过程中,或者是精密测量过程中,为了不受到外部电荷的影响,会把电路封闭在金属壳内。

传输微弱电信号的导线(屏蔽线),外表也是用金属丝编成的网包围起来的

